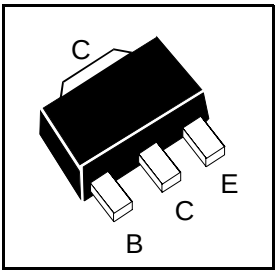
SOT89 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR

FCX589

ISSUE 3 - OCTOBER 1995 ✪

PARTMARKING DETAIL – P89



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-30	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-2	A
Continuous Collector Current	I_C	-1	A
Base Current	I_B	-200	mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-65 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltages	$V_{(BR)CBO}$	-50		V	I_C=-100µA
	$V_{(BR)CEO}$	-30		V	I_C=-10mA*
	$V_{(BR)EBO}$	-5		V	I_E=-100µA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		-100	nA	V_{CB}=-30V
Collector -Emitter Cut-Off Current	I_{CES}		-100	nA	V_{CES}=-30V
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		-100	nA	V_{EB}=-4V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.35 -0.65	V	I_C=-1A, I_B=-100mA* I_C=-2A, I_B=-200mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-1.2	V	I_C=-1A, I_B=-100mA*
Base-Emitter Turn-on Voltage	$V_{BE(on)}$		-1.1	V	I_C=-1A, V_{CE}=-2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	100 100 80 40	300		I_C=-1mA, V_{CE}=-2V* I_C=-500mA, V_{CE}=-2V* I_C=-1A, V_{CE}=-2V* I_C=-2A, V_{CE}=-2V*
Transition Frequency	f_T	100		MHz	I_C=-100mA, V_{CE}=-5V f=100MHz
Output Capacitance	C_{obo}		15	pF	V_{CB}=-10V, f=1MHz

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤ 2%
For typical Characteristics graphs see FMMT549 datasheet

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9